

P-i-n фотодиод на основе кремния ФД342М

Фотодиод предназначен для применения в качестве высокочувствительного быстродействующего приемника инфракрасного излучения в составе оптико-электронной аппаратуры различного назначения.

Фотодиод состоит из пластины высокоомного кремния с p-i-n структурой расположенной в металлическом корпусе с металлостеклянными выводами и плоским входным окном



Технические характеристики:

Количество фоточувствительных элементов (ФЧЭ)	4
Диаметр ФЧЭ, мм	14 (для 4 элементов)
Диапазон спектральной чувствительности, мкм	0,4 – 1,1
Токовая монохроматическая чувствительность на длине волны 1,06 мкм, А/Вт, не менее	0,2
Темновой ток, мкА, не более	7
Емкость фотодиода, пФ, не более	20
Рабочее напряжение, В	120
Граничная частота, МГц, не менее	5